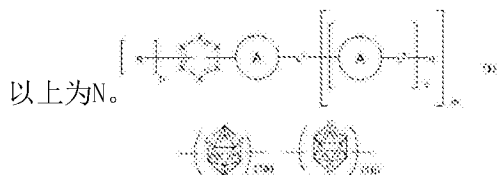


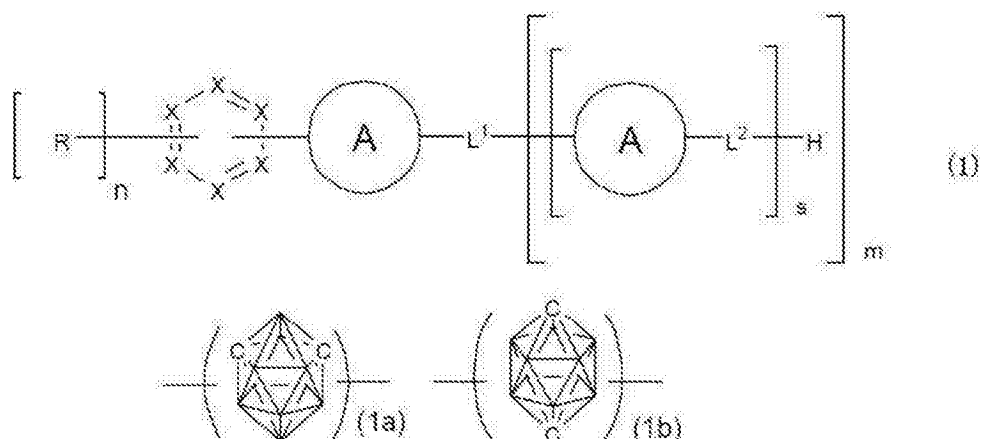


(43)申请公布日 2017. 11. 28

权利要求书2页 说明书29页 附图1页



1. 一种有机电场发光元件用材料,其特征在于:包含通式(1)所表示的碳硼烷化合物,
[化1]



此处,环A独立地表示式(1a)或式(1b)所表示的 $C_2B_{10}H_{10}$ 的二价碳硼烷基,s表示重复数,独立地为1~4的整数;m、n表示取代数,m为0~4的整数,n为0~3的整数;其中,当 $m=1$ 时, $s=1$;

X独立地表示N、CH或C,X中的至少两个为N;

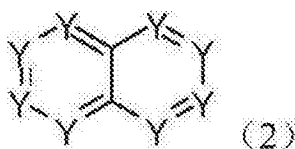
R表示碳数1~12的烷基、碳数1~12的烷氧基、经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烷基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烷基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基;

L^1 表示单键、或者m+1价的经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烷基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烷基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基,在 $m=1$ 的情形时,为具有1,3,5-三嗪环、嘧啶环、吡嗪环或哒嗪环的芳香族杂环基,或者包含至少一个这些中的任意环的连结芳香族基或单键;此处,在末端为 L^1-H 的情形时,所述 L^1-H 可为碳数1~12的烷基或碳数1~12的烷氧基;

L^2 独立地表示单键、或者二价的经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烷基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烷基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基;此处,在末端为 L^2-H 的情形时,所述 L^2-H 可为碳数1~12的烷基或碳数1~12的烷氧基;

其中, L^1 及 L^2 中,与环A直接键结的环不为下式(2)所表示的两环的含氮杂环、二苯并噻吩环或二苯并呋喃环;

[化2]



此处,Y独立地表示N、CH或C,Y中的1个~4个为N。

2. 根据权利要求1所述的有机电场发光元件用材料,其中m为0或1的整数。
3. 根据权利要求1所述的有机电场发光元件用材料,其中环A为式(1a)所表示的 $C_2B_{10}H_{10}$ 的二价碳硼烷基。
4. 根据权利要求1所述的有机电场发光元件用材料,其中 L^1 及 L^2 分别独立地为单键、或

者经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基。

5. 根据权利要求1所述的有机电场发光元件用材料,其中 L^1 及 L^2 分别独立地为单键、或者经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、或者所述芳香族烃基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基。

6. 根据权利要求1所述的有机电场发光元件用材料,其中,通式(1)中,X所构成的芳香族环为嘧啶环、吡嗪环、哒嗪环或1,3,5-三嗪环。

7. 一种有机电场发光元件,其是在基板上层叠阳极、有机层及阴极而成的有机电场发光元件,所述有机电场发光元件的特征在于:具有包含根据权利要求1至6中任一项所述的有机电场发光元件用材料的有机层。

8. 根据权利要求7所述的有机电场发光元件,其中包含所述有机电场发光元件用材料的有机层为选自由发光层、电子输送层及空穴阻挡层所组成的群组中的至少一层。

9. 根据权利要求8所述的有机电场发光元件,其特征在于包含所述有机电场发光元件用材料的有机层为含有磷光发光掺杂物的发光层。

有机电场发光元件用材料及使用其的有机电场发光元件

技术领域

[0001] 本发明涉及一种使用碳硼烷化合物作为有机电场发光元件用材料的有机电场发光元件,详细而言,本发明涉及一种对包含有机化合物的发光层施加电场而放出光的薄膜型装置。

背景技术

[0002] 通常,作为有机电场发光元件(以下称为有机电致发光(Electroluminescence, EL)元件)的最简单的结构,包含发光层及夹持所述层的一对对向电极。即,在有机EL元件中,利用如下现象:若在两电极间施加电场,则自阴极注入电子,自阳极注入空穴,它们在发光层中再结合而放出光。

[0003] 近年来,使用有机薄膜的有机EL元件正被开发。尤其是为了提高发光效率,以提高自电极注入载体的效率为目的而进行电极种类的最优化,通过开发在电极间设置含有芳香族二胺的空穴输送层与含有8-羟基喹啉铝络合物(Alq_3)的发光层作为薄膜的元件,在现有的使用蒽等单晶的元件相比,发光效率得以大幅改善,因此旨在于具有自发光·高速响应性等特征的高性能平板中加以实用化而逐渐发展。

[0004] 又,作为提高元件的发光效率的尝试,业界还正研究使用磷光而非荧光。以所述设置有含有芳香族二胺的空穴输送层与含有 Alq_3 的发光层的元件为首的多数元件是利用荧光发光者,但通过使用磷光发光、即利用来自三重激发态的发光,与现有的使用荧光(单重态)的元件相比,可期待将效率提高3倍~4倍左右。为了所述目的而一直研究以香豆素衍生物或二苯甲酮衍生物作为发光层,但仅获得极低的亮度。又,作为利用三重态的尝试,而一直研究使用铕络合物,但此还未达到高效率的发光。近年来,以如专利文献1所示的发光的高效率化或长寿命化为目的,正以铕络合物等有机金属络合物为中心而进行大量研究。

[0005] [现有技术文献]

[0006] [专利文献]

[0007] 专利文献1:W001/041512A

[0008] 专利文献2:日本专利特开2001-313178号公报

[0009] 专利文献3:日本专利特开2005-162709号公报

[0010] 专利文献4:日本专利特开2005-166574号公报

[0011] 专利文献5:US2012/0319088A

[0012] 专利文献6:W02013/094834A

[0013] [非专利文献]

[0014] 非专利文献1:《美国化学学会志(J. Am. Chem. Soc.)》2012, 134, 17982-17990

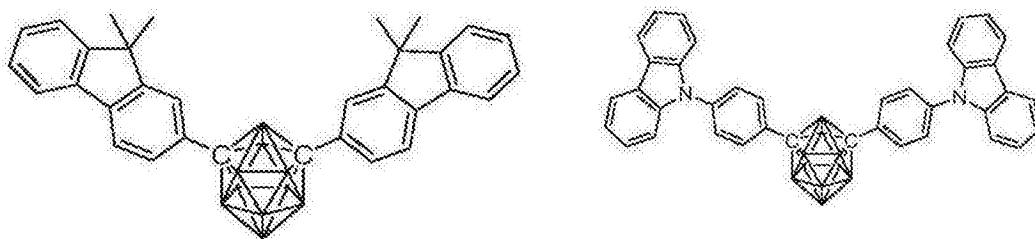
[0015] 为了获得高发光效率,所使用的主体材料与所述掺杂物材料同时变得重要。作为主体材料而提出的具有代表性者可列举专利文献2所介绍的咔唑化合物的4,4'-双(9-咔唑基)联苯(4,4'-bis(9-carbazolyl)-biphenyl, CBP)。在将CBP用作以三(2-苯基吡啶)铕络合物($Ir(ppy)_3$)为代表的绿色磷光发光材料的主体材料的情形时,由于CBP具有容易流失

空穴而不易流失电子的特性,电荷注入平衡受到破坏,过量的空穴向电子输送层侧流出,结果来自1r (ppy)₃的发光效率降低。

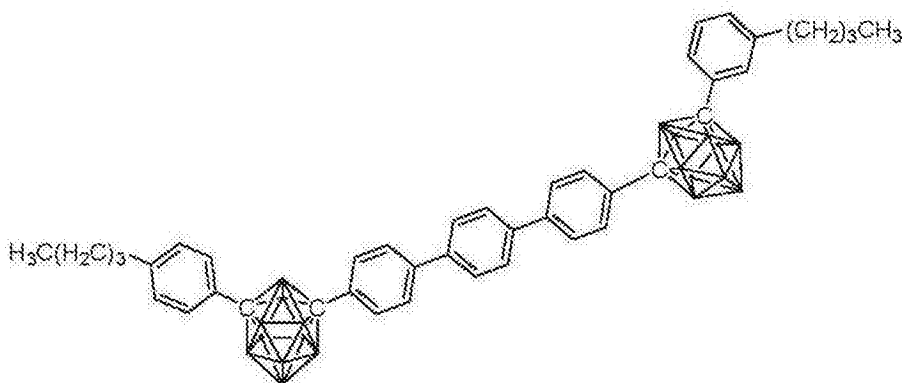
[0016] 如上所述,为了以有机EL元件获得高发光效率,需要具有高的三重激发能、且可在两电荷(空穴·电子)注入输送特性方面取得平衡的主体材料。进而,期待电化学性稳定、同时具备高耐热性与优异的非晶稳定性的化合物,要求进一步改良。

[0017] 在专利文献3、专利文献4、专利文献5、专利文献6及非专利文献1中,揭示有如以下所示的碳硼烷化合物。

[0018] [化1]



[0019]



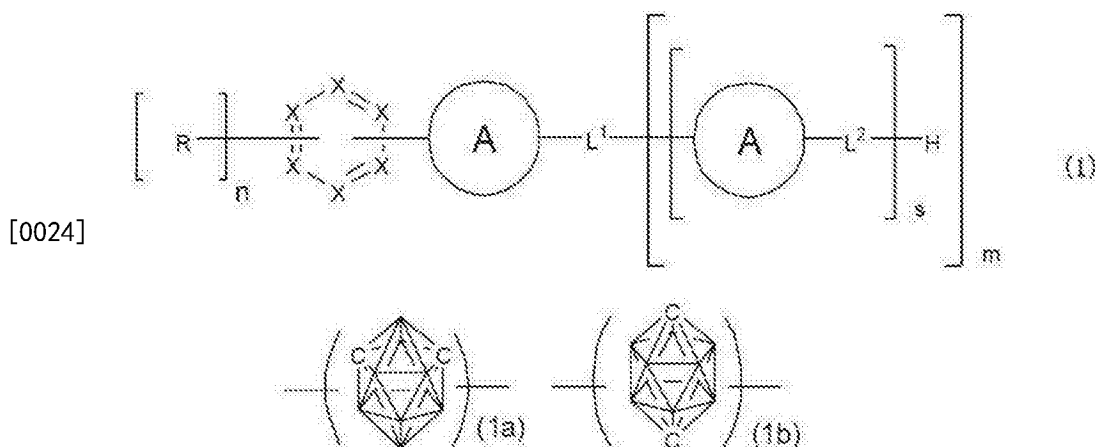
发明内容

[0020] 为了将有机EL元件应用于平板显示器等显示元件,需改善元件的发光效率,同时充分确保驱动时的稳定性。本发明鉴于所述现状,目的在于提供一种高效率且具有高的驱动稳定性的实用上有用的有机EL元件及适合其的化合物。

[0021] 本发明人等人努力研究的结果,发现通过将包含至少两个以上的氮的六元环基与碳硼烷骨架直接键结而得的化合物用于有机EL元件,而表现出优异的特性,从而完成本发明。

[0022] 本发明是一种包含通式(1)所表示的碳硼烷化合物的有机电场发光元件用材料。

[0023] [化2]



[0025] 此处,环A表示式(1a)或式(1b)所表示的 $C_2B_{10}H_{10}$ 的二价碳硼烷基,在分子内存在多个环A的情形时可相同也可不同。 s 表示重复数,为1~4的整数。 m 、 n 表示取代数, m 为0~4的整数, n 为0~3的整数。其中,当 $m=1$ 时, $s=1$ 。

[0026] X 表示N、CH或C, X 中的至少两个为N。

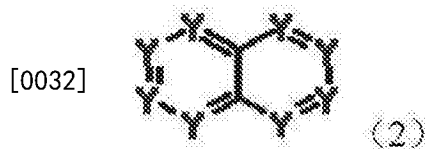
[0027] R 表示碳数1~12的烷基、碳数1~12的烷氧基、经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基。

[0028] L^1 表示单键、或者 $m+1$ 价的经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基。在 $m=1$ 的情形时, L^1 为包含至少一个1,3,5-三嗪环、嘧啶环、吡嗪环或哒嗪环的芳香族杂环基或连结芳香族基、或者单键。又,末端的 L^1-H 可为碳数1~12的烷基或碳数1~12的烷氧基;

[0029] L^2 独立地表示单键、或者二价的经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基。又,末端的 L^2-H 可为碳数1~12的烷基或碳数1~12的烷氧基,在分子内存在多个 L^2 的情形时可相同也可不同。

[0030] 其中, L^1 及 L^2 中,与环A直接键结的环不为二苯并噻吩环、二苯并呋喃环或下式(2)所表示的两环的含氮杂环。

[0031] [化3]



[0033] 此处, Y 独立地表示N、CH或C, Y 中的1个~4个为N。

[0034] 又,在为连结芳香族基的情形时可为直链状也可为分支状,连结的芳香族环可相同也可不同。

[0035] 将本发明的优选方案示于以下。

[0036] 所述通式(1)中,满足以下的1)~4)的任一者以上。

[0037] 1) 环A为式(1a)所表示的 $C_2B_{10}H_{10}$ 的二价碳硼烷基。

[0038] 2) L^1 及 L^2 分别独立地为单键、或者经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、

经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基。

[0039] 3) L^1 及 L^2 分别独立地为单键、或者经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、或者选自所述芳香族烃基中的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基。

[0040] 4) m 为0或1~4的整数,优选为0或1的整数。

[0041] 所述通式(1)所表示的碳硼烷化合物中的氢的一部分或全部也可经取代为氘。

[0042] 又,本发明涉及一种有机电场发光元件,其是在基板上层叠阳极、有机层及阴极而成,且所述有机电场发光元件具有包含所述有机电场发光元件用材料的有机层。

[0043] 进而,优选为包含所述有机电场发光元件用材料的有机层为含有磷光发光掺杂物的发光层。

[0044] 本发明的有机电场发光元件用材料采用包含至少两个以上的氮的六元环芳香族基与碳硼烷骨架直接键结而得的结构。具有此种结构特征的碳硼烷化合物中,影响电子注入输送性的最低未占用分子轨域(Lowest Unoccupied Molecular Orbital, LUMO)广泛分布于电子耐受性良好的含氮六元芳香族环上,因此电子注入输送性提高,进而,通过改变取代于其上的 R ,可以更高的水平控制电子注入输送性。根据以上特征,通过将其用于有机EL元件,可达成元件的驱动电压的降低及高的发光效率。

附图说明

[0045] 图1是表示有机EL元件的一结构例的剖面图。

具体实施方式

[0046] 本发明的有机电场发光元件用材料由所述通式(1)表示。

[0047] 此处,环A为碳硼烷基,6个X所构成的芳香族环为包含至少两个以上的氮的含氮六元环基。以下,还将通式(1)中的6个X所构成的芳香族环称为X所构成的芳香族环。

[0048] 通式(1)中,在存在多个相同记号的情形时,它们可相同也可不同。例如,不仅是在分子内存在多个的环A、X,而且根据 n 、 s 、 m 的数而存在多个的 L^2 、 R 等也为可相同也可不同。

[0049] 通式(1)中,环A表示式(1a)或式(1b)所表示的 $C_2B_{10}H_{10}$ 的二价碳硼烷基。优选为式(1a)所表示的碳硼烷基。在分子内存在多个环A的情形时可相同也可不同,优选为两者均为式(1a)所表示的碳硼烷基。式(1a)或式(1b)所具有的两个结合键可由C生成,也可由B生成,与 L^1 、 L^2 键结的结合键优选为由C生成。

[0050] L^1 表示单键、或者 $m+1$ 价的经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基,在为连结芳香族基的情形时可为直链状也可为分支状,连结的芳香族环可相同也可不同。其中,在 $m=1$ 的情形时, L^1 为具有1,3,5-三嗪环、嘧啶环、吡嗪环或哒嗪环的所述芳香族杂环基,或者包含至少一个这些中的任意环的所述连结芳香族基或单键。

[0051] L^2 表示单键、或者二价的经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基,在为连结芳香族基的情形时可为直链状也可为分

支状, 连结的芳香族环可相同也可不同。又, 末端的 L^1 -H或 L^2 -H可为碳数1~12的烷基或碳数1~12的烷氧基。

[0052] 其中, L^1 及 L^2 中, 与环A直接键结的环不为二苯并噻吩环、二苯并呋喃环或所述式(2)所表示的两环的含氮杂环。

[0053] 此处, 所谓与环A直接键结的环, 是指 L^1 或 L^2 为芳香族基(*Ar)的情形时、或者 L^1 或 L^2 为连结芳香族基(*Ar1-Ar2-Ar3)的情形时的*Ar或*Ar1。此处,*Ar及*Ar1为与环A(碳硼烷基)直接键结的芳香族环。所述环可具有取代基。

[0054] 式(2)所表示的两环的含氮杂环、二苯并噻吩环及二苯并呋喃环分别由下式表示, Y独立地表示N、CH或C, Y中的1个~4个为N, 任意一个碳原子具有结合键。

[0055] [化4]



[0057] L^1 及 L^2 优选为单键、或者经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基, 更优选为单键、或者经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、或者所述芳香族烃基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基。

[0058] R表示氢、碳数1~12的烷基、碳数1~12的烷氧基、经取代或未经取代的碳数6~30的芳香族烃基、经取代或未经取代的碳数3~16的芳香族杂环基、或者所述芳香族烃基或芳香族杂环基的芳香族环的2个~6个连结而构成的连结芳香族基, 在为连结芳香族基的情形时可为直链状也可为分支状, 连结的芳香环可相同也可不同。

[0059] L^1 、 L^2 及R的说明中, 关于与芳香族烃基、芳香族杂环基及连结芳香族基相关的说明, 除 L^1 为 $m+1$ 价的基、 L^2 为二价的基、而且R的情形时为一价的基以外均相同。

[0060] 作为未经取代的芳香族烃基的具体例, 可列举自苯、萘、蒽、蒽基、菲、三亚苯、四亚苯、荧蒽(fluoranthene)、芘、等芳香族烃化合物中去除氢而生成的基, 优选为自苯、萘、蒽、菲或三亚苯中去除氢而生成的基。

[0061] 作为未经取代的芳香族杂环基的具体例, 可列举自吡啶、嘧啶、吡嗪、哒嗪、三嗪、喹啉、异喹啉、喹喔啉、喹唑啉、茶啉、咪唑、吡啶、氮杂环庚三烯、三苯并氮杂环庚三烯、吩嗪、二苯并呋喃、二苯并噻吩、二氮杂蒽、吩噻嗪、吩噻吩、二苯并磷杂环戊二烯(dibenzophosphole)、二苯并硼杂环戊二烯(dibenzoborole)等芳香族杂环化合物中去除氢而生成的基, 优选为自吡啶、嘧啶、三嗪、二苯并呋喃、二苯并噻吩或咪唑中去除氢而生成的基。

[0062] 本说明书中所述的连结芳香族基是指自芳香族烃化合物或芳香族杂环化合物连结多个而成的芳香族化合物中去除氢而生成的基。连结芳香族基为将芳香族环通过直接键结连结2个~6个而构成的基, 所连结的芳香族环可相同也可不同, 也可包含芳香族烃基与芳香族杂环基两者。所连结的芳香族环的个数优选为2~4, 更优选为2或3。所连结的芳香族烃基与芳香族杂环基的碳数为所述芳香族烃基与芳香族杂环基的碳数的范围内, 且合计的

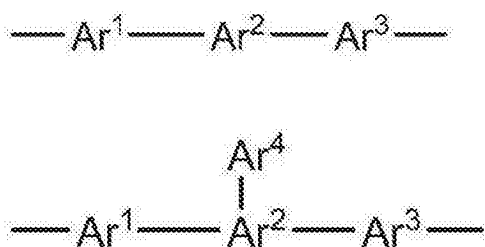
碳数优选为6~50的范围。

[0063] 本说明书中,芳香族环是指芳香族烃化合物或芳香族杂环化合物的芳香族环,芳香族基是指芳香族烷基、芳香族杂环基或连结芳香族基。当对芳香族烷基、芳香族杂环基与连结芳香族基进行区分时,芳香族烷基、芳香族杂环基不具有通过单键与其键结的芳香族烷基或芳香族杂环基。

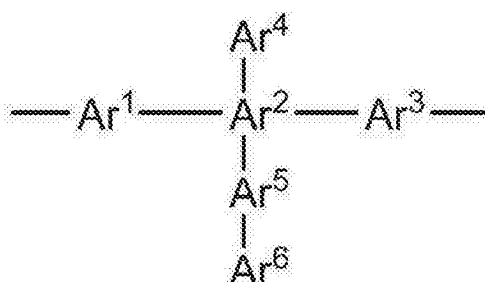
[0064] 作为所述连结芳香族基的具体例,可列举:自联苯、三联苯、苯基萘、二苯基萘、苯基蒽、二苯基蒽、二苯基茈、联吡啶、联嘧啶、联三嗪、双呋唑、苯基吡啶、苯基嘧啶、苯基三嗪、苯基呋唑、二苯基吡啶、二苯基三嗪、双呋唑基苯等中去除氢而生成的基。

[0065] 在所述连结芳香族基为二价基的情形时,例如可由下式表示,且以直链状、或分支状进行连结。

[0066] [化5]



[0067]



[0068] ($\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^6$ 为未经取代的芳香族烃环或芳香族杂环)

[0069] L^1 、 L^2 及R中,所述芳香族烷基、芳香族杂环基或连结芳香族基可具有取代基。作为这些芳香族基具有取代基的情形时的取代基,宜为碳数1~12的烷基、碳数1~12的烷氧基、或碳数2~13的酰基,这些基可为直链状、分支状、环状。优选为碳数1~10的烷基、碳数1~10的烷氧基、或碳数2~11的酰基,更优选为碳数1~4的烷基、碳数1~2的烷氧基、或乙酰基。本说明书中所述的芳香族烷基、芳香族杂环基或连结芳香族基的碳数不包括取代基的碳数。然而,优选为包括取代基的碳数在内的合计的碳数满足所述碳数。

[0070] 此处,烷基是指脂肪族烷基,除链状烷基以外,还包含由环、萜烯类等所生成的环状烷基。作为烷基的具体例,可列举:甲基、乙基、丙基、异丙基、丁基、戊基、己基、辛基等链状或分支状的烷基,环戊基、环己基等环烷基等环状烷基。

[0071] 作为烷氧基的具体例,可列举:由所述甲基、乙基、丙基等烷基所衍生的甲氧基、乙氧基、丙氧基等烷氧基。

[0072] 作为酰基的具体例,可列举乙酰基、乙基羰基等酰基。

[0073] 又,在末端的 $\text{L}^1\text{-H}$ 或 $\text{L}^2\text{-H}$ 为碳数1~12的烷基或碳数1~12的烷氧基的情形时,也可与所述取代基中所说明的烷基、烷氧基同样地为直链状、分支状、环状。

[0074] 通式(1)中,s表示重复数,为1~4的整数。m、n表示取代数,m为0~4的整数,n为0~3的整数。其中,当m=1时,s=1。优选为m为0或1~3的整数,进而优选为1~2的整数,更优选为1,s为1或2的整数,n为0~2的整数。

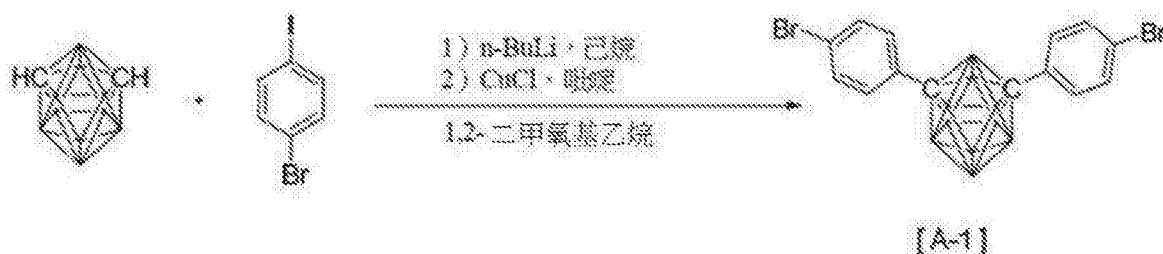
[0075] 通式(1)中,X表示N、CH或C,6个X中的至少两个为N。优选为包含2个或3个N。在为C的情形时,具有与R或环A键结的结合键。所述X所构成的芳香族环优选为1,3,5-三嗪环、嘧啶环、吡嗪环或哒嗪环。

[0076] 通式(1)所表示的碳硼烷化合物可根据目标化合物的结构选择原料,并使用公知的方法进行合成。

[0077] 可以《有机金属化学杂志(Journal of Organometallic Chemistry)》,1993,462,p19-29中所示的合成例为参考,根据以下的反应式合成(A-1)。可应用或变更所述反应式来获得通式(1)的碳硼烷化合物。

[0078] [化6]

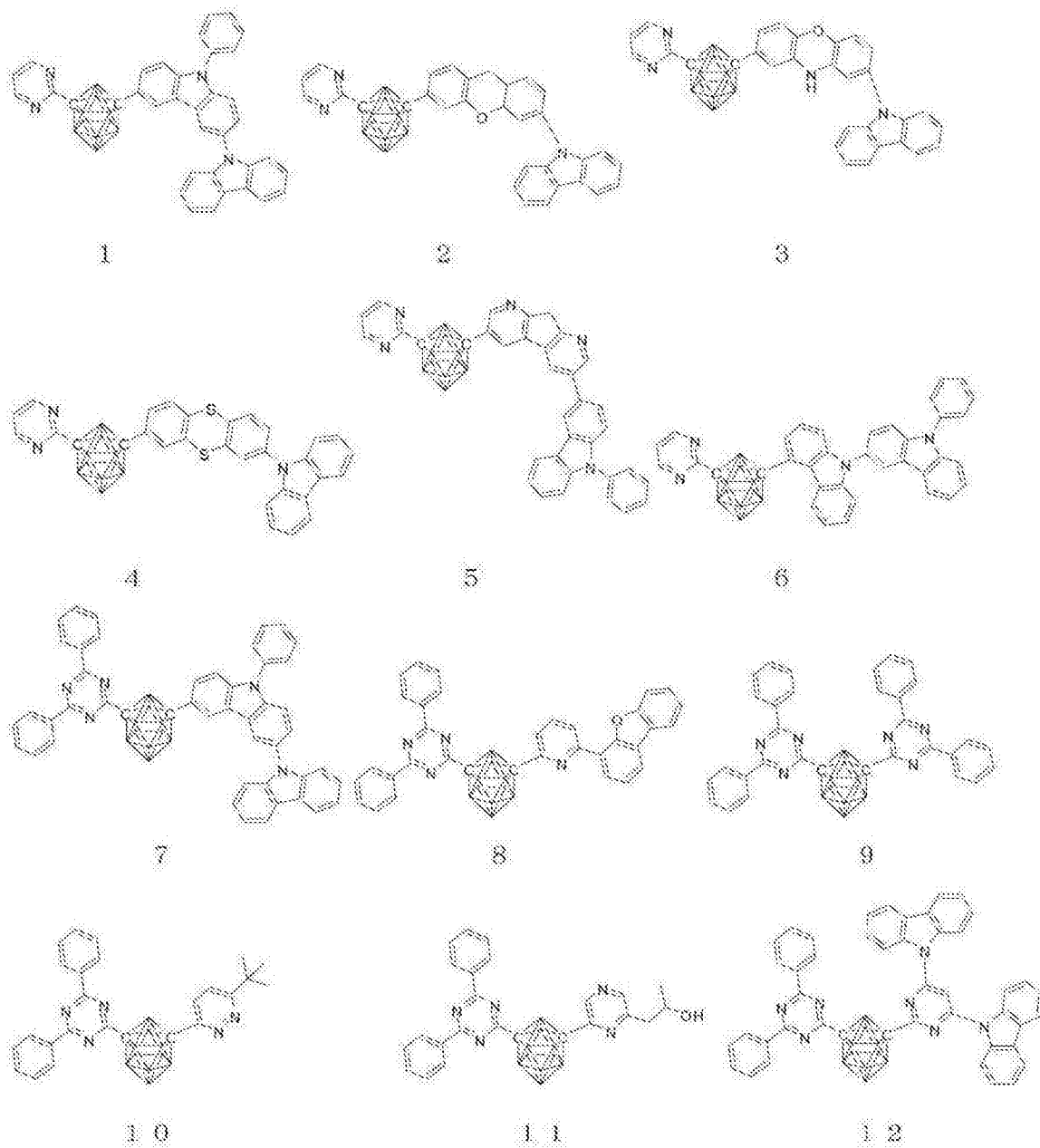
[0079]



[0080] 将通式(1)所表示的碳硼烷化合物的具体例示于以下,但本发明的有机电场发光元件用材料并不限于这些。

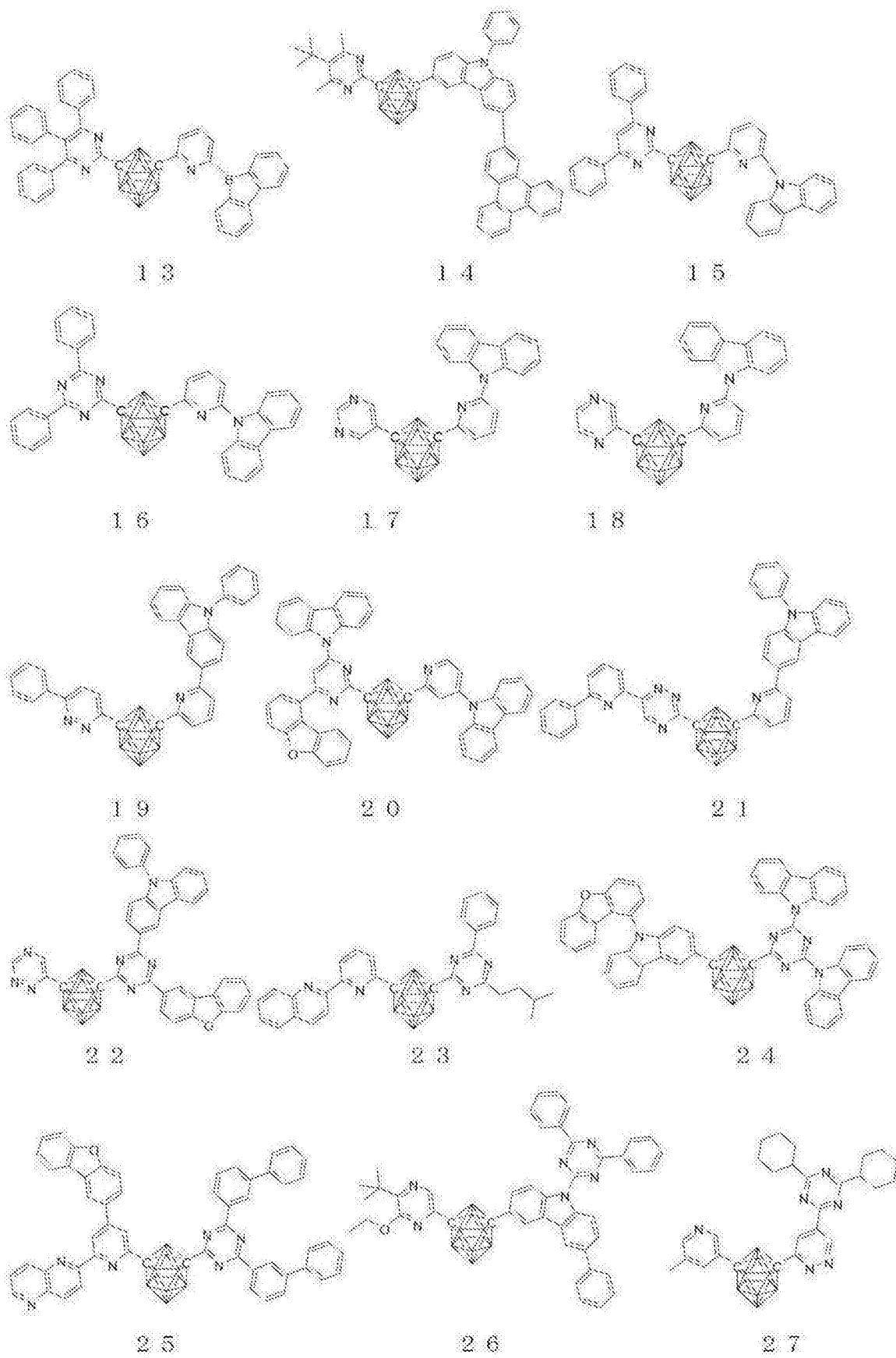
[0081] [化7]

[0082]



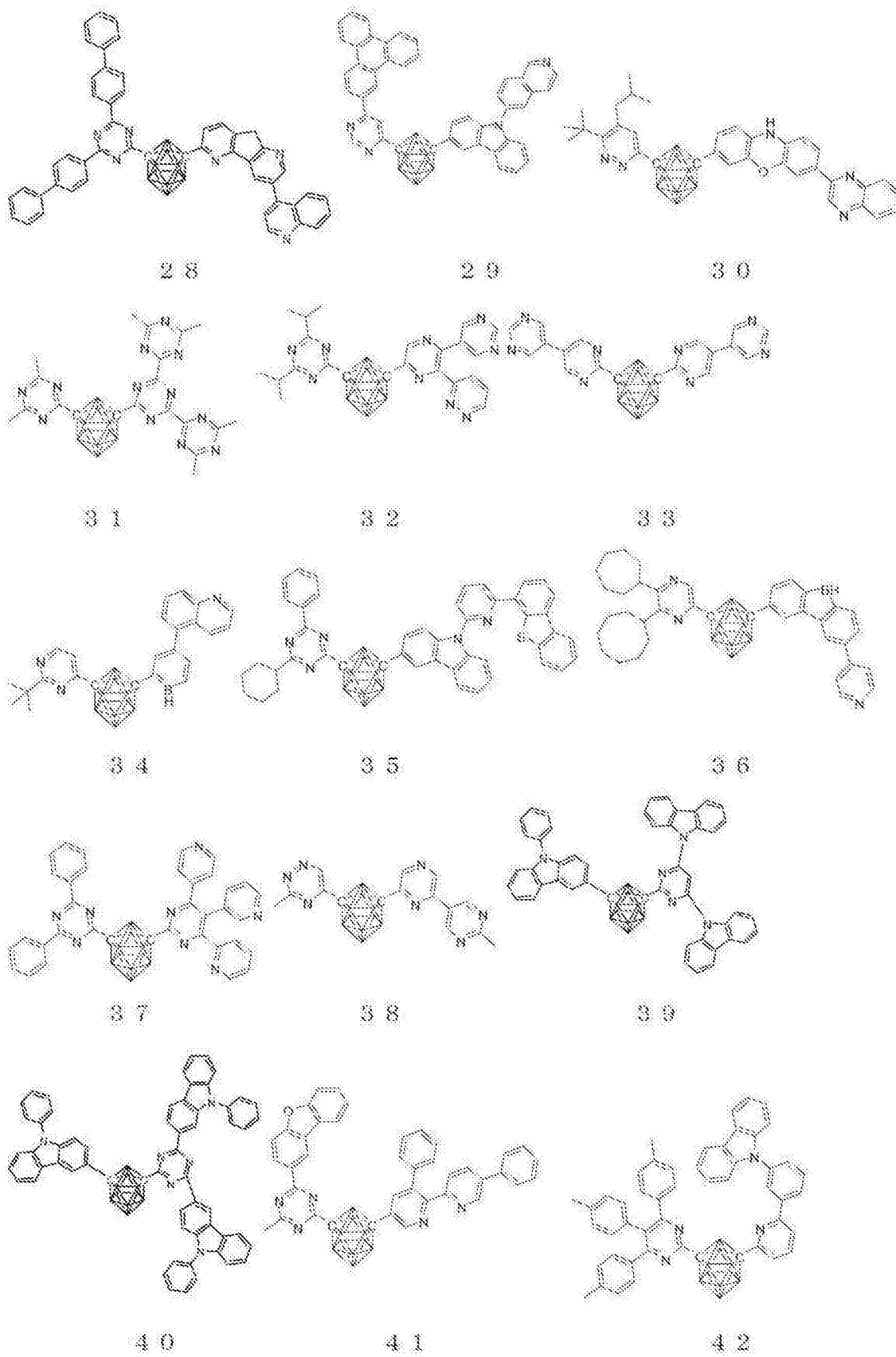
[0083] [化8]

[0084]

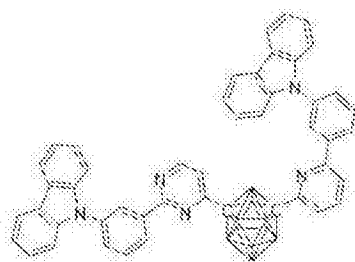


[0085] [化9]

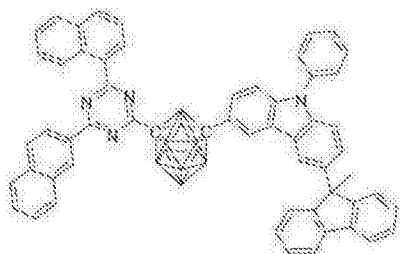
[0086]



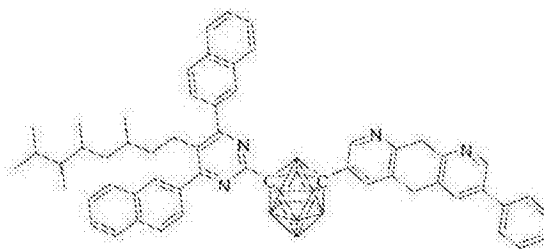
[0087] [化10]



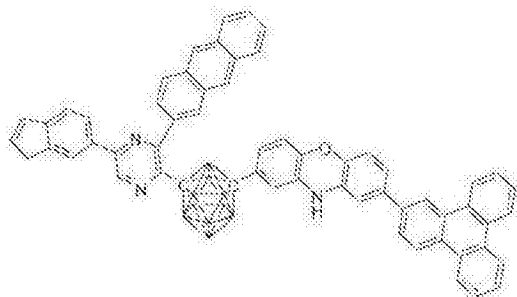
43



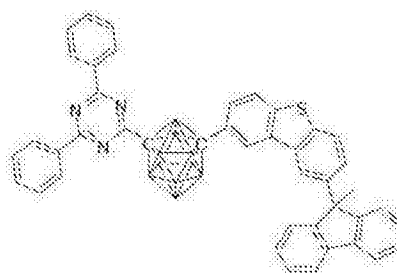
44



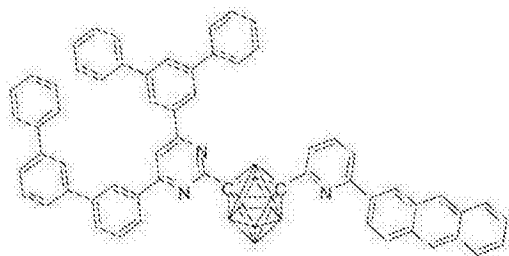
45



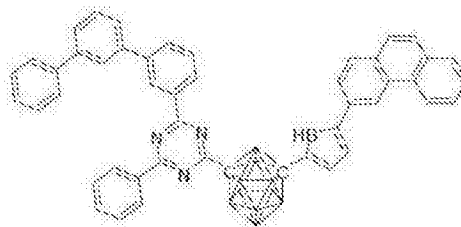
46



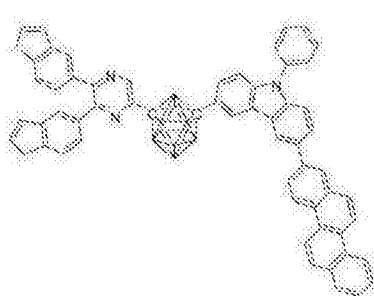
47



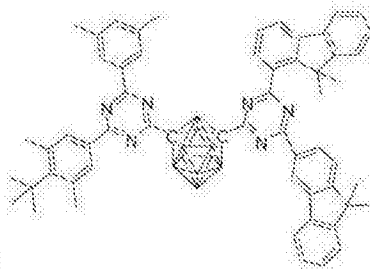
48



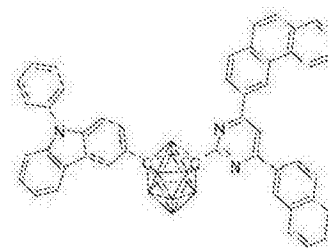
49



50



51

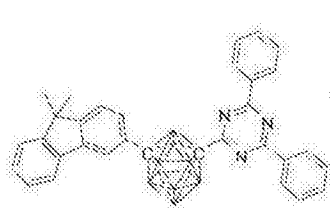


52

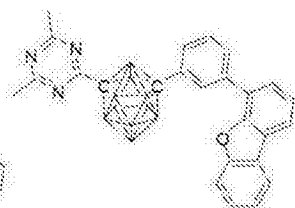
[0088]

[0089] [化11]

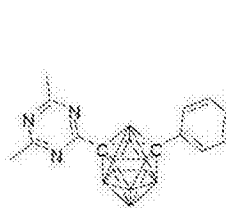
[0090]



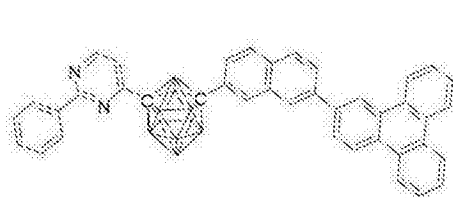
53



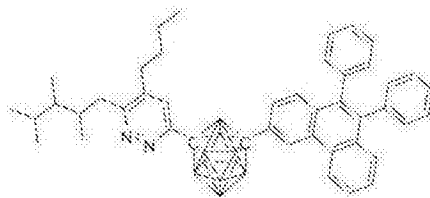
54



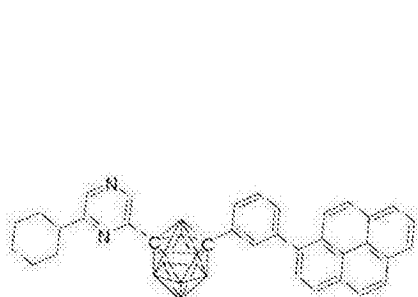
55



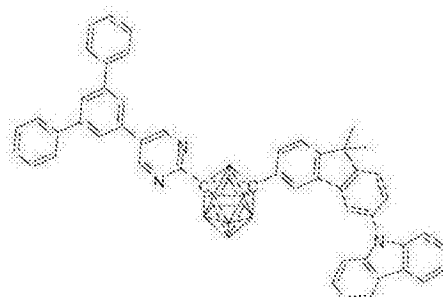
56



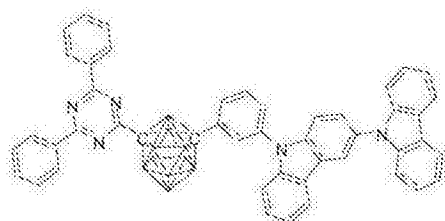
57



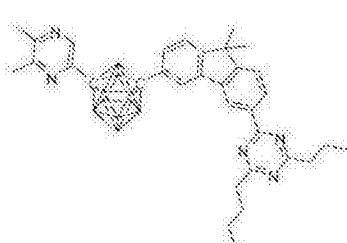
58



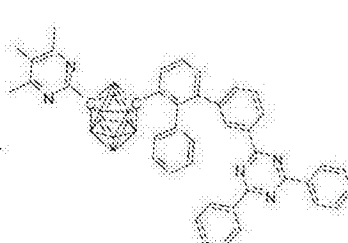
59



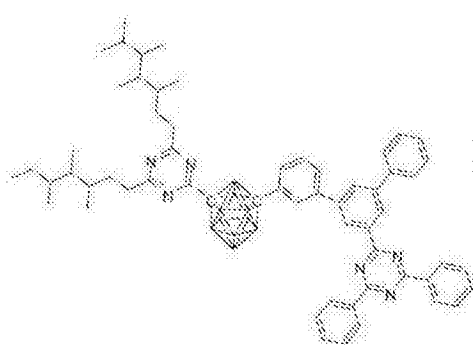
60



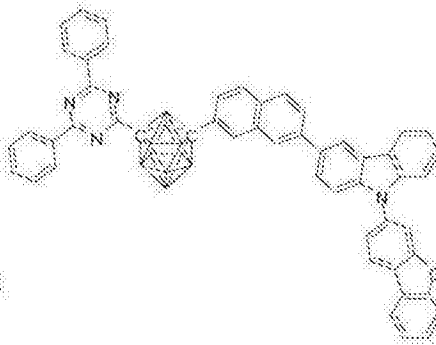
61



62



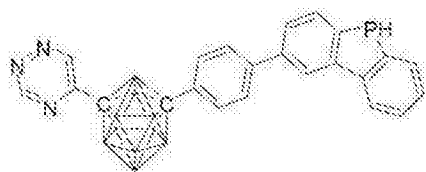
63



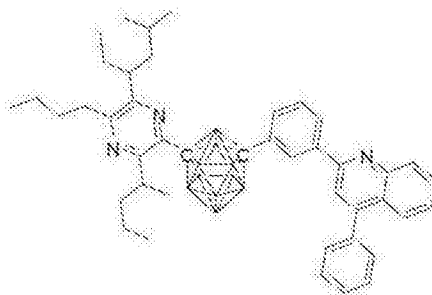
64

[0091] [化12]

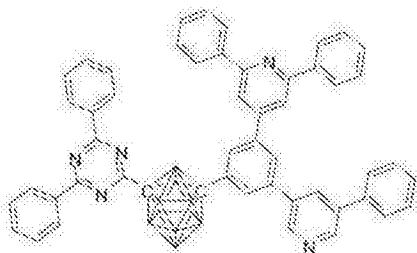
[0092]



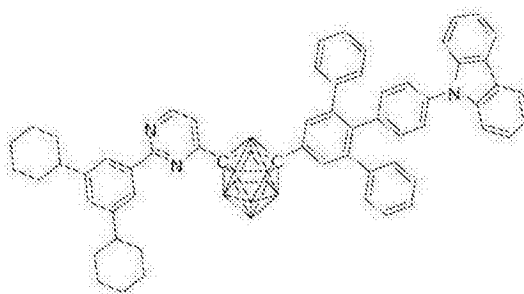
65



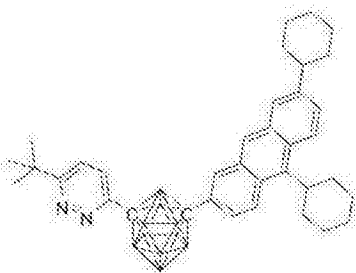
66



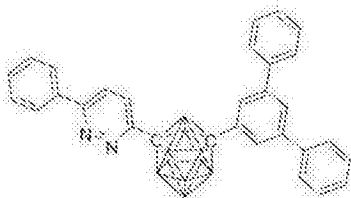
67



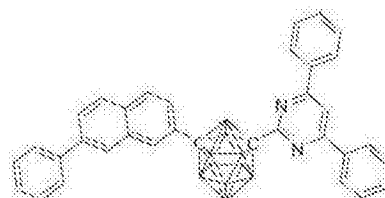
68



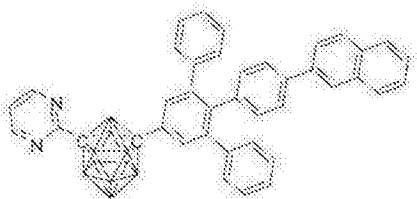
69



70



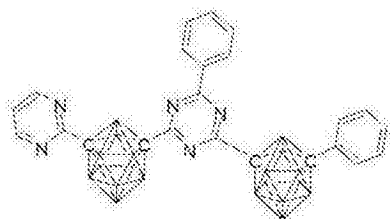
71



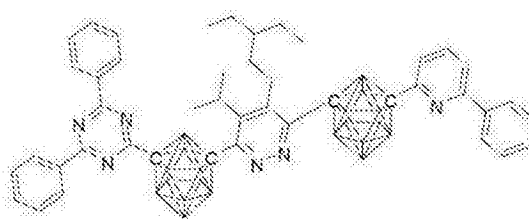
72

[0093] [化13]

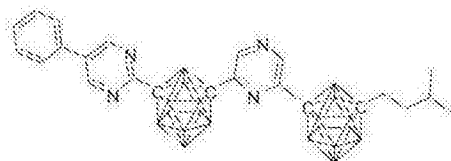
[0094]



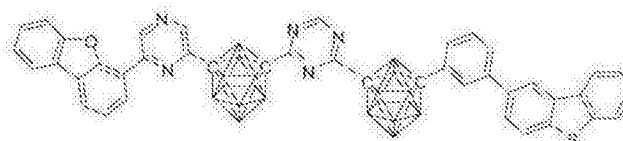
7 3



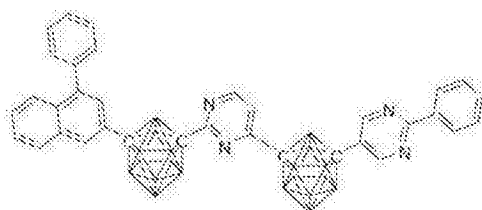
7 4



7 5



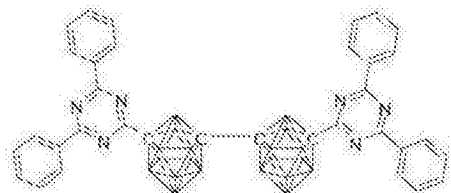
7 6



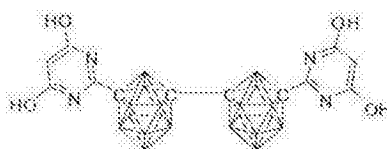
7 7



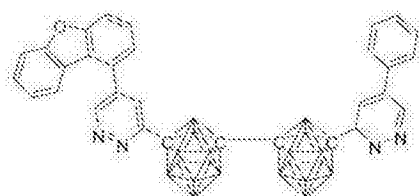
7 8



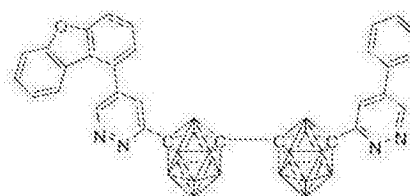
7 9



8 0



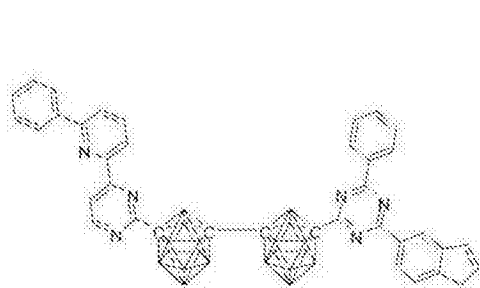
8 1



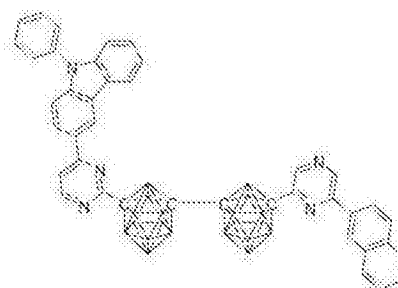
8 2

[0095] [化14]

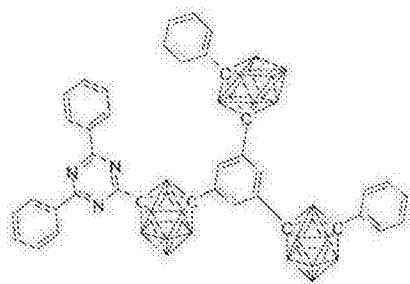
[0096]



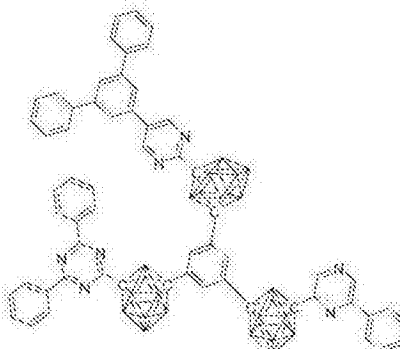
8 3



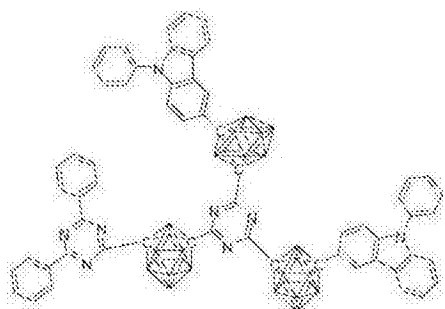
8 4



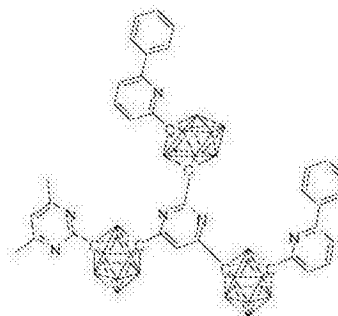
8 5



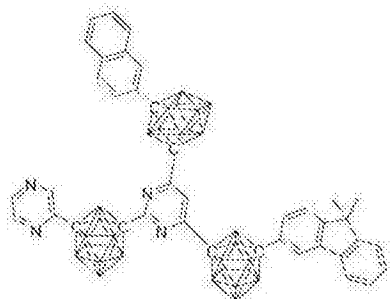
8 6



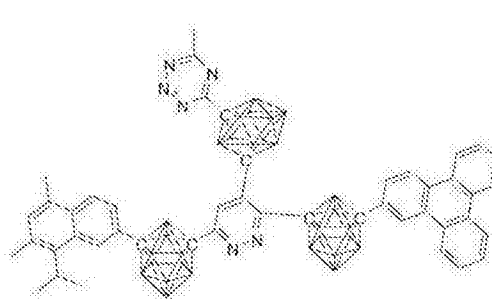
8 7



8 8



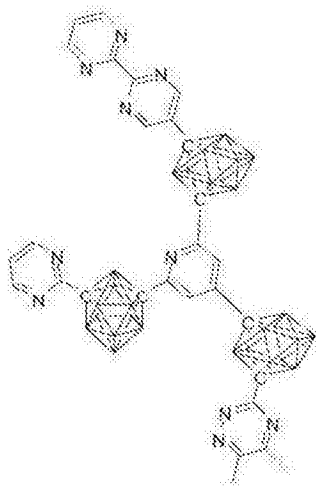
8 9



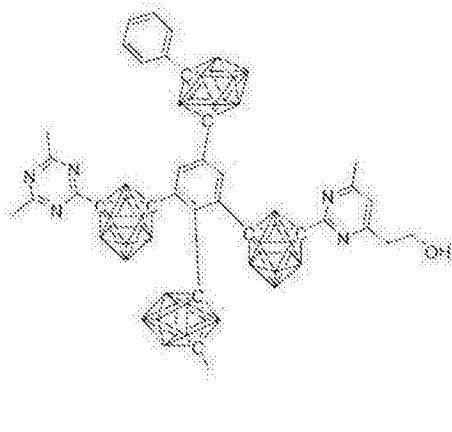
9 0

[0097] [化15]

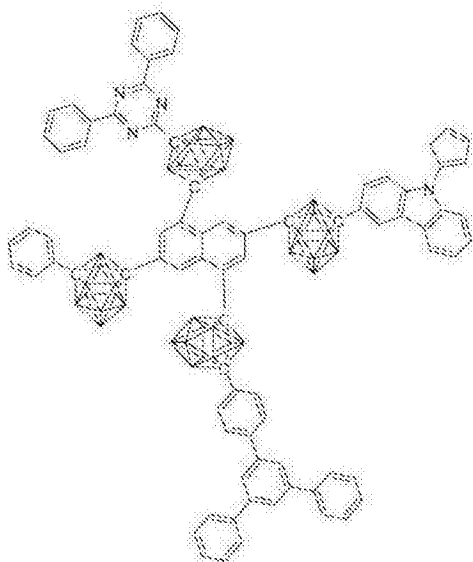
[0098]



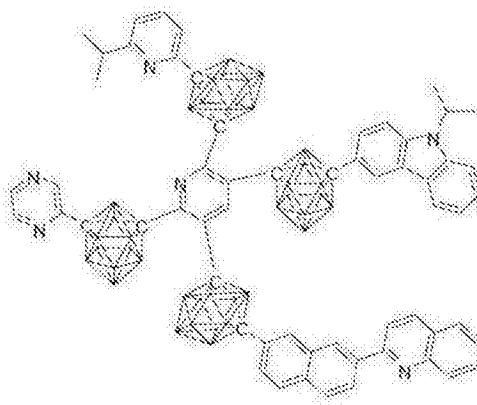
9 1



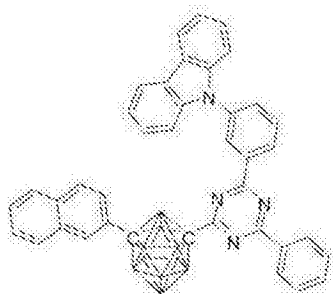
9 2



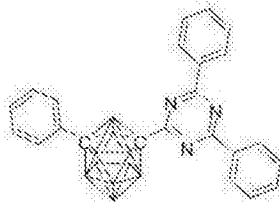
9 3



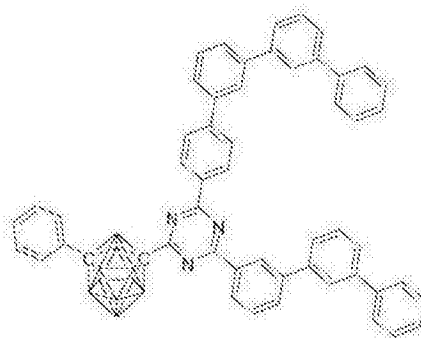
9 4



9 5



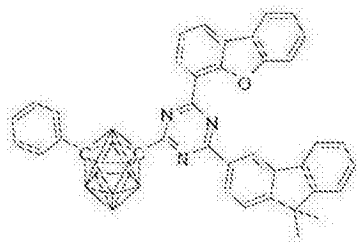
9 6



9 7

[0099] [化16]

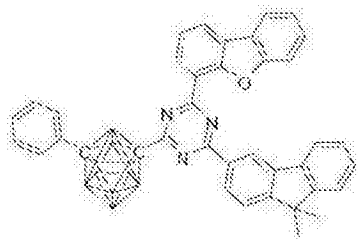
[0100]



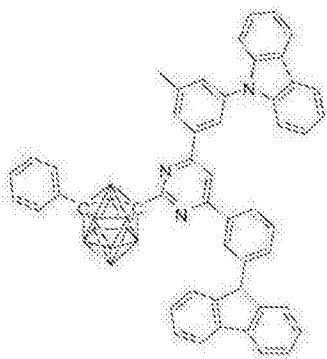
98



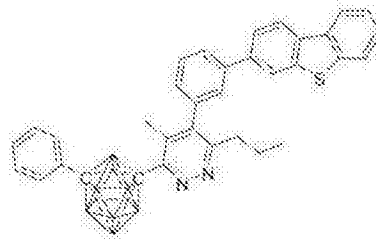
99



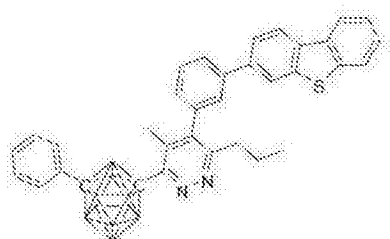
100



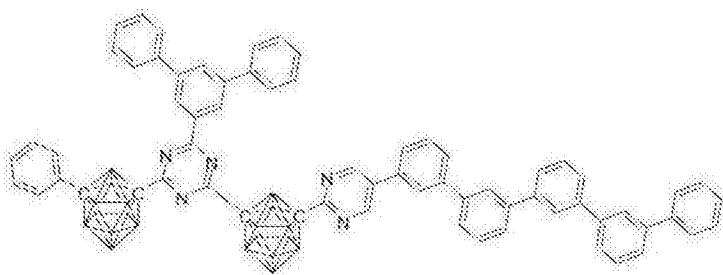
101



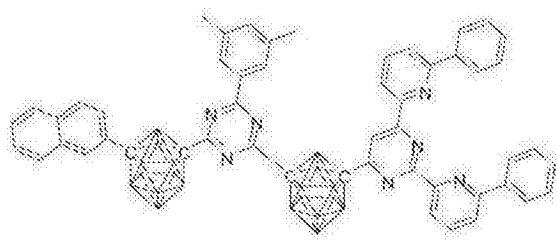
102



103



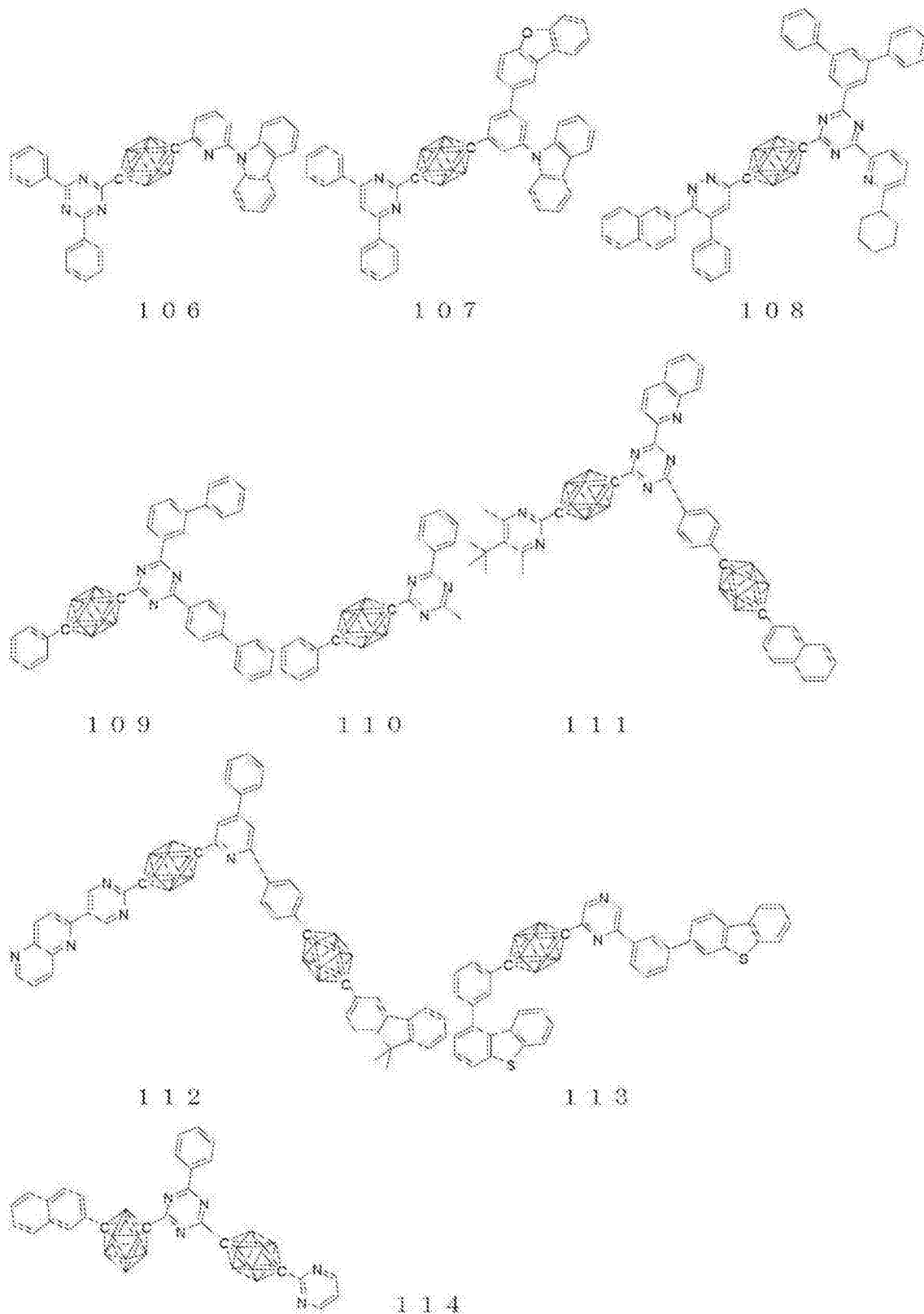
104



105

[0101] [化17]

[0102]



[0103] 本发明的有机电场发光元件用材料包含通式(1)所表示的碳硼烷化合物(还称为本发明的碳硼烷化合物、或本发明的材料)。通过使在基板上层叠阳极、多层有机层及阴极而成的有机EL元件的至少一层有机层含有本发明的碳硼烷化合物,可提供优异的有机电场发光元件。作为使之含有的有机层,适合的是发光层、电子输送层或空穴阻挡层。此处,在用

于发光层的情形时,除了可用作含有荧光发光、延迟荧光发光或磷光发光性掺杂物的发光层的主体材料以外,还可将本发明的化合物用作放射荧光及延迟荧光的有机发光材料。在用作放射荧光及延迟荧光的有机发光材料的情形时,优选为使用激发单重态能量、激发三重态能量中的至少任一者具有高于本发明的化合物的值的其他有机化合物作为主体材料。更优选为含有本发明的碳硼烷化合物作为含有磷光发光掺杂物的发光层的主体材料。

[0104] 继而,对使用本发明的有机电场发光元件用材料的有机EL元件进行说明。

[0105] 本发明的有机EL元件在层叠于基板上的阳极与阴极之间具有含有至少一层发光层的有机层,且至少一层有机层包含本发明的有机电场发光元件用材料。有利的是在发光层中同时包含磷光发光掺杂物与本发明的有机电场发光元件用材料。

[0106] 继而,一面参照附图,一面对本发明的有机EL元件的结构进行说明,但本发明的有机EL元件的结构并不受任何图示者限定。

[0107] 图1是表示用于本发明的通常的有机EL元件的结构例的剖面图,1表示基板,2表示阳极,3表示空穴注入层,4表示空穴输送层,5表示发光层,6表示电子输送层,7表示阴极。在本发明的有机EL元件中,也可与发光层邻接而具有激子阻挡层,又,也可在发光层与空穴注入层之间具有电子阻挡层。激子阻挡层可插入至发光层的阳极侧、阴极侧中的任一侧,还可同时插入至两侧。在本发明的有机EL元件中,含有基板、阳极、发光层及阴极作为必需层,必需层以外的层可具有空穴注入输送层、电子注入输送层,进而可在发光层与电子注入输送层之间具有空穴阻挡层。再者,空穴注入输送层是指空穴注入层与空穴输送层中的任一者或两者,电子注入输送层是指电子注入层与电子输送层中的任一者或两者。

[0108] 再者,还可为与图1相反的结构,即,还可在基板1上依序层叠阴极7、电子输送层6、发光层5、空穴输送层4、空穴注入层3、阳极2,在此情形时,还可视需要而追加或省略层。

[0109] -基板-

[0110] 本发明的有机EL元件优选为由基板支持。所述基板并无特别限制,为自以往起有机EL元件所惯用者即可,例如,可使用包含玻璃、透明塑料、石英等者。

[0111] -阳极-

[0112] 作为有机EL元件中的阳极,优选可使用以功函数大(4eV以上)的金属、合金、导电性化合物及这些的混合物作为电极物质者。作为此种电极物质的具体例,可列举Au等金属、CuI、氧化铟锡(Indium Tin Oxide,ITO)、SnO₂、ZnO等导电性透明材料。又,也可使用IDIXO(In₂O₃-ZnO)等非晶质且可制作透明导电膜的材料。阳极可利用蒸镀、溅射等方法使这些电极物质形成薄膜,并利用光刻法形成所需形状的图案,或者在不甚需要图案精度的情形时(100μm以上左右),也可在所述电极物质的蒸镀、溅射时经由所需形状的掩模形成图案。或者在使用如有机导电性化合物般可涂布的物质的情形时,还可使用印刷方式、涂布方式等湿式成膜法。在自所述阳极选取发光的情形时,理想为使透过率大于10%,又,作为阳极的片电阻优选为数百Ω/□以下。进而,膜厚还取决于材料,但通常在10nm~1000nm、优选为在10nm~200nm的范围内选择。

[0113] -阴极-

[0114] 另一方面,作为阴极,使用以功函数小(4eV以下)的金属(称为电子注入性金属)、合金、导电性化合物及这些的混合物作为电极物质者。作为此种电极物质的具体例,可列举:钠、钠-钾合金、镁、锂、镁/铜混合物、镁/银混合物、镁/铝混合物、镁/铟混合物、铝/氧化

铝(Al_2O_3)混合物、铟、锂/铝混合物、稀土金属等。这些中,就电子注入性及对氧化等的耐久性的方面而言,适宜为电子注入性金属、与作为功函数的值大于其且稳定的金属的第二金属的混合物,例如,镁/银混合物、镁/铝混合物、镁/铟混合物、铝/氧化铝(Al_2O_3)混合物、锂/铝混合物、铝等。阴极可通过利用蒸镀、溅射等方法使这些电极物质形成薄膜而制作。又,作为阴极的片电阻优选为数百 $\Omega/\square$ 以下,膜厚通常在 $10\text{nm}\sim 5\mu\text{m}$ 、优选为在 $50\text{nm}\sim 200\text{nm}$ 的范围内选择。再者,为了使发出的光透过,若有机EL元件的阳极或阴极中的任一者为透明或半透明,则发光亮度提高而优选。

[0115] 又,通过阴极中将所述金属以 $1\text{nm}\sim 20\text{nm}$ 的膜厚制作后,将阳极的说明中所列举的导电性透明材料制作于其上,可制作透明或半透明的阴极,通过应用此方法,可制作阳极与阴极两者具有透过性的元件。

[0116] -发光层-

[0117] 发光层是通过分别自阳极及阴极注入的空穴及电子再结合而产生激子后进行发光的层,发光层中包含有机发光材料与主体材料。

[0118] 在发光层为荧光发光层的情形时,荧光发光材料可单独使用至少一种荧光发光材料,但优选为将荧光发光材料用作荧光发光掺杂物,且包含主体材料。

[0119] 作为发光层中的荧光发光材料,可使用通式(1)所表示的碳硼烷化合物,但由于根据大量专利文献等而可知,因此还可自这些中选择。例如可列举:以苯并噻唑衍生物、苯并噻吩衍生物、苯并咪唑衍生物、苯乙烯基苯衍生物、聚苯基衍生物、二苯基丁二烯衍生物、四苯基丁二烯衍生物、萘酰亚胺衍生物、香豆素衍生物、缩合芳香族化合物、紫环酮衍生物、噻二唑衍生物、噻吩衍生物、醛连氮(alidazine)衍生物、吡咯烷衍生物、环戊二烯衍生物、双苯乙烯基蒽衍生物、喹吖啶酮衍生物、吡咯并吡啶衍生物、噻二唑并吡啶衍生物、苯乙烯基胺衍生物、二酮基吡咯并吡咯衍生物、芳香族二次甲基(dimethyldiyne)化合物、8-羟基喹啉(quinolinol)衍生物的金属络合物或吡咯亚甲基衍生物的金属络合物、稀土络合物、过渡金属络合物为代表的各种金属络合物等;聚噻吩、聚苯、聚苯亚乙烯(polyphenylene vinylene)等聚合物化合物、有机硅烷衍生物等。优选可列举缩合芳香族化合物、苯乙烯基化合物、二酮基吡咯并吡咯化合物、噻吩化合物、吡咯亚基金属络合物、过渡金属络合物、镧系元素(lanthanoid)络合物,更优选可列举并四苯、芘、蒽、三亚苯、苯并[c]菲、苯并[a]蒽、并五苯、花、荧蒽、苊并荧蒽(acenaphthofluoranthene)、二苯并[a,j]蒽、二苯并[a,h]蒽、二苯并[a,h]蒽、苯并[a]并四苯、并六苯、蒽嵌蒽、萘并[2,1-f]异喹啉、 α -萘并菲啶、菲并噻唑(phenanthrooxazole)、喹啉并[6,5-f]喹啉、苯并萘并噻吩(benzothiophanthrene)等。它们可具有烷基、芳基、芳香族杂环基、二芳基氨基作为取代基。

[0120] 作为发光层中的荧光主体材料,可使用通式(1)所表示的碳硼烷化合物,但由于根据大量专利文献等而可知,因此还可自这些中选择。例如,可使用如下物质但并无特别限定:萘、蒽、菲、芘、蒽、并四苯、三亚苯、花、荧蒽、苊、茚等具有缩合芳基环的化合物或其衍生物; $\text{N,N}'$ -二萘基- $\text{N,N}'$ -二苯基-4,4'-二苯基-1,1'-二胺等芳香族胺衍生物;以三(8-羟基喹啉)铝(III)为首的金属螯合化类罂辛(oxinoid)化合物;二苯乙烯基苯衍生物等双苯乙烯基衍生物、四苯基丁二烯衍生物、茚衍生物、香豆素衍生物、噻二唑衍生物、吡咯并吡啶衍生物、紫环酮衍生物、环戊二烯衍生物、吡咯并吡咯衍生物、噻二唑并吡啶衍生物、二苯并咪唑衍生物、咪唑衍生物、吡啶并咪唑衍生物、三嗪衍生物;聚合物系中的聚苯亚乙烯衍生物、

聚对亚苯衍生物、聚茚衍生物、聚乙烯基呋唑衍生物、聚噻吩衍生物等。

[0121] 在使用所述荧光发光材料作为荧光发光掺杂物且包含主体材料的情形时,荧光发光掺杂物在发光层中所含有的量可为0.01重量%~20重量%的范围,优选为0.1重量%~10重量%的范围。

[0122] 通常,有机EL元件是自阳极、阴极两电极向发光物质注入电荷而产生激发状态的发光物质并使其发光。在电荷注入型有机EL元件的情形时,一般认为,所产生的激子中,25%被激发为单重激发态,剩余75%被激发为三重激发态。如《先进材料(Advanced Materials)》2009,21,4802-4806.所示可知,特定的荧光发光物质的能量通过系间跨越等而向三重激发态跃迁后,通过三重态-三重态湮灭或热能的吸收,而向单重激发态进行反向系间跨越并放射荧光,从而表现出热活化延迟荧光。在本发明的有机EL元件中还可表现出延迟荧光。在此情形时,还可包含荧光发光及延迟荧光发光两者。但也可发光的一部分或局部地为来自主体材料的发光。

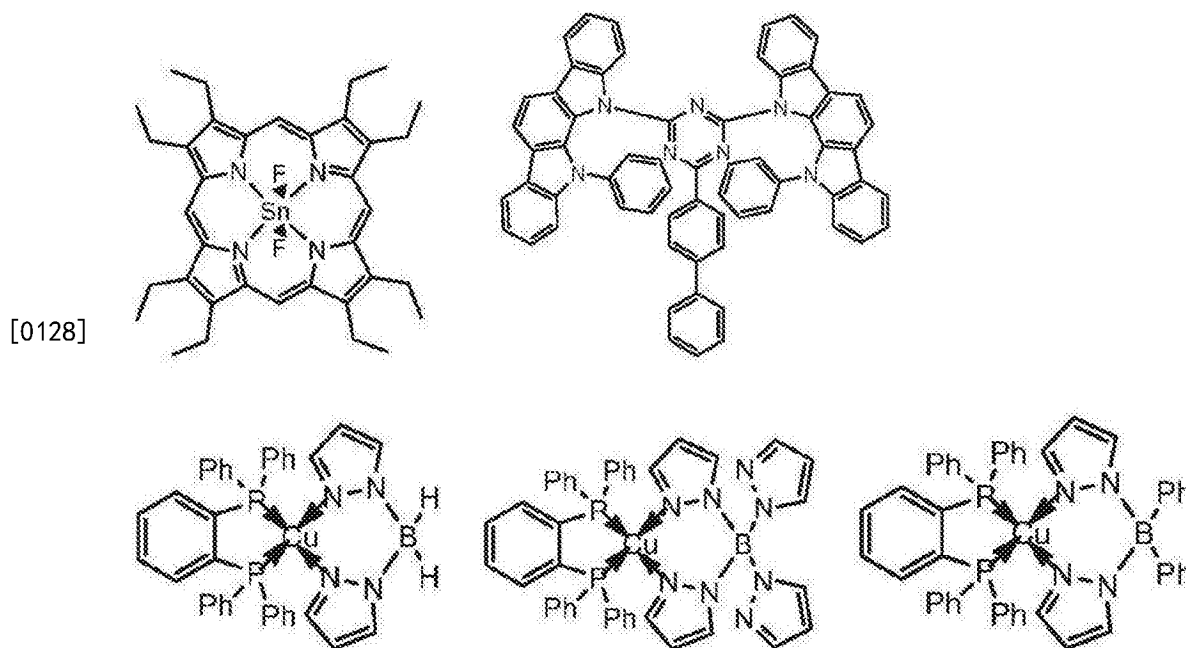
[0123] 在发光层为延迟荧光发光层的情形时,延迟发光材料可单独使用至少一种延迟发光材料,但优选为将延迟荧光材料用作延迟荧光发光掺杂物,且包含主体材料。

[0124] 作为发光层中的延迟荧光发光材料,可使用通式(1)所表示的碳硼烷化合物,还可自公知的延迟荧光发光材料中进行选择。例如,可列举:锡络合物、吡啶并呋唑衍生物、铜络合物、呋唑衍生物等。具体而言,可列举以下的非专利文献、专利文献中所记载的化合物,但并不限于这些化合物。

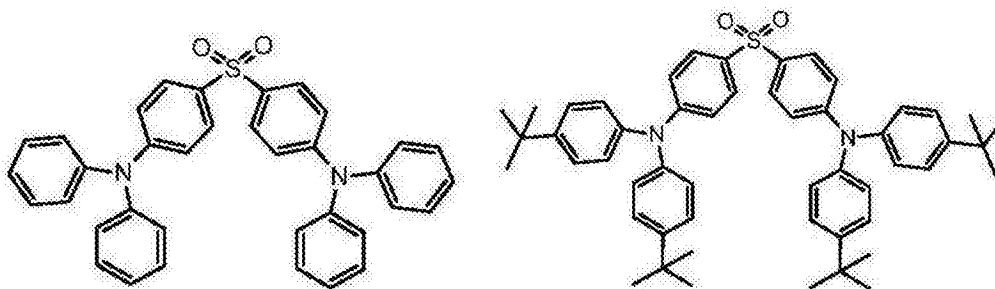
[0125] 1)《先进材料(Adv.Mater.)》2009,21,4802-4806;2)《应用物理通信(Appl.Phys.Lett.)》98,083302(2011);3)日本专利特开2011-213643号公报;4)《美国化学学会志(J.Am.Chem.Soc.)》2012,134,14706-14709。

[0126] 例示延迟发光材料的具体的例,但并不限于下述化合物。

[0127] [化18]



[0129]



[0130] 在将所述延迟荧光发光材料用作延迟荧光发光掺杂物且包含主体材料的情形时，延迟荧光发光掺杂物于发光层中所含有的量可为0.01重量%~50重量%的范围，优选为0.1重量%~20重量%的范围，更优选为0.01%~10%的范围。

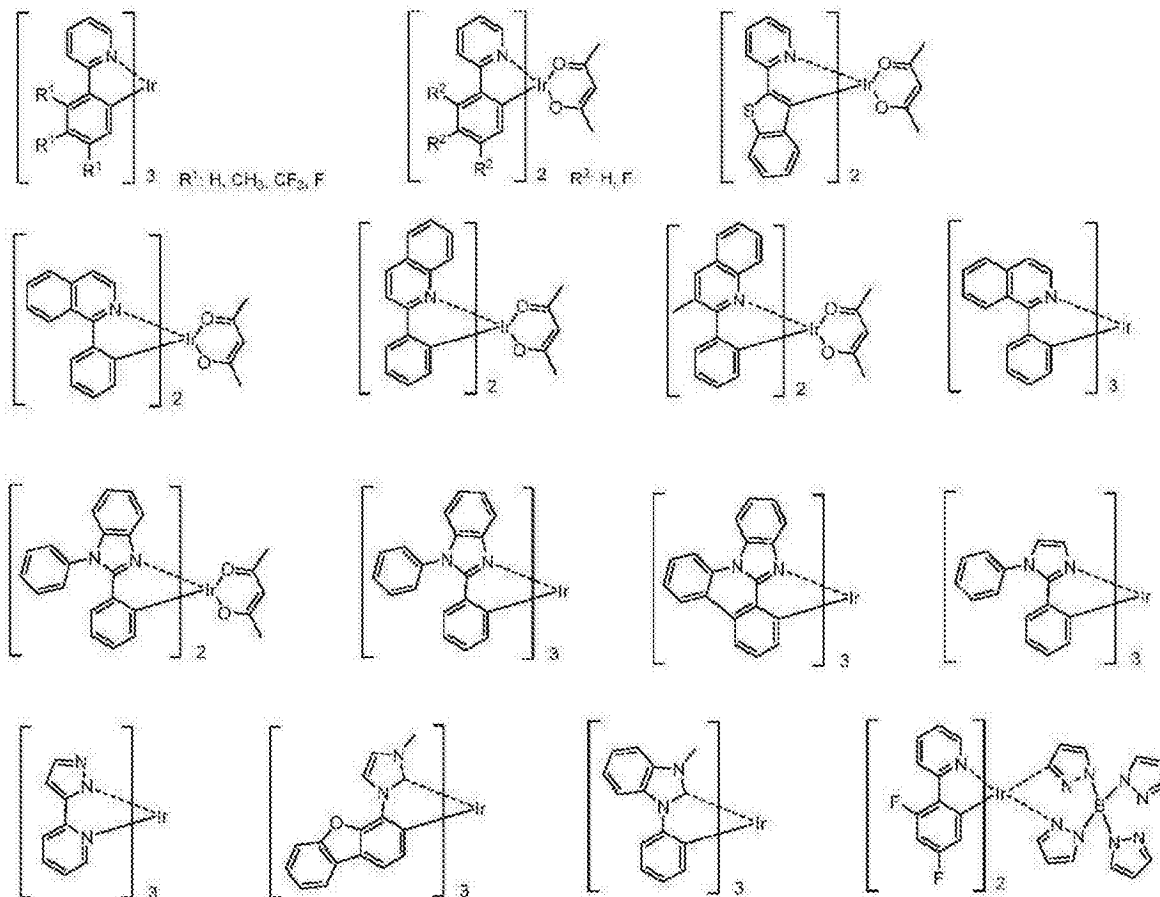
[0131] 作为发光层中的延迟荧光主体材料，可使用通式(1)所表示的碳硼烷化合物，还可自所述碳硼烷以外的化合物中进行选择。例如，可使用如下物质但并无特别限定：萘、蒽、菲、芘、并四苯、三亚苯、茈、荧蒽、芴、茚等具有缩合芳基环的化合物或其衍生物；N,N'-二萘基-N,N'-二苯基-4,4'-二苯基-1,1'-二胺等芳香族胺衍生物；以三(8-羟基喹啉)铝(III)为首的金属螯合化类羧辛化合物；二苯乙烯基苯衍生物等双苯乙烯基衍生物、四苯基丁二烯衍生物、茚衍生物、香豆素衍生物、噻二唑衍生物、吡咯并吡啶衍生物、紫环酮衍生物、环戊二烯衍生物、吡咯并吡咯衍生物、噻二唑并吡啶衍生物、二苯并呋喃衍生物、呋唑衍生物、吡啶并呋唑衍生物、三嗪衍生物；聚合物系中的聚苯亚乙烯衍生物、聚对亚苯衍生物、聚茚衍生物、聚乙烯基呋唑衍生物、聚噻吩衍生物、芳基硅烷衍生物等。

[0132] 在发光层为磷光发光层的情形时，发光层包含磷光发光掺杂物与主体材料。作为磷光发光掺杂物材料，可为含有包含选自钪、铈、钇、银、镧、铕、铥、铒及金中的至少一种金属的有机金属络合物者。

[0133] 作为优选的磷光发光掺杂物，可列举具有Ir等贵金属元素作为中心金属的Ir(ppy)₃等的络合物类、Ir(bt)₂•acac₃等的络合物类、PtOEt₃等的络合物类。将这些络合物类的具体例示于以下，但并不限定于下述的化合物。

[0134] [化19]

[0135]



[0136] 所述磷光发光掺杂物在发光层中所含有的量可为2重量%~40重量%的范围,优选为以5重量%~30重量%的范围为宜。

[0137] 在发光层为磷光发光层的情形时,作为发光层中的主体材料,优选为使用本发明的所述通式(1)所表示的碳硼烷化合物。然而,在将所述碳硼烷化合物用于发光层以外的其他任意有机层的情形时,用于发光层的材料也可所述碳硼烷化合物或碳硼烷化合物以外的其他主体材料。又,也可并用所述碳硼烷化合物与其他主体材料。进而,也可并用多种公知的主体材料。

[0138] 作为可使用的公知的主体化合物,优选为具有空穴输送能力、电子输送能力、且防止发光的长波长化、并具有高的玻璃化温度的化合物。

[0139] 由于此种其他主体材料根据大量专利文献等而可知,因此可自这些中选择。作为主体材料的具体例,并无特别限定,可列举:以吡啶衍生物、咪唑衍生物、吡啶并咪唑衍生物、三唑衍生物、噁唑衍生物、噁二唑衍生物、咪唑衍生物、聚芳基烷烃衍生物、吡啶啉衍生物、吡啶啉酮衍生物、苯二胺衍生物、芳基胺衍生物、氨基取代查耳酮衍生物、苯乙烯基噻吩衍生物、茚酮衍生物、茚衍生物、二苯乙烯衍生物、硅氮烷衍生物、芳香族叔胺化合物、苯乙烯基胺化合物、芳香族二次甲基(dimethyldiene)系化合物、卟啉系化合物、蒽醌二甲烷衍生物、蒽酮衍生物、二苯基醌衍生物、二氧化噻喃衍生物、碳硼烷衍生物、萘蒽等杂环四羧酸酐、酞菁衍生物、8-羟基喹啉衍生物的金属络合物或金属酞菁、苯并噻唑或苯并噻唑衍生物的金属络合物为代表的各种金属络合物;聚硅烷系化合物、聚(N-乙烯基咪唑)衍生物、苯胺系共聚物、噻吩低聚物、聚噻吩衍生物、聚苯衍生物、聚苯亚乙烯衍生物、聚茚衍生物等高分

子化合物等。

[0140] 发光层可为荧光发光层、延迟荧光发光层或磷光发光层中的任一者,优选为磷光发光层。

[0141] -注入层-

[0142] 所谓注入层是为了降低驱动电压或提高发光亮度而设置于电极与有机层间的层,包括空穴注入层与电子注入层,可存在于阳极与发光层或空穴输送层之间及阴极与发光层或电子输送层之间。注入层可视需要而设置。

[0143] -空穴阻挡层-

[0144] 所谓空穴阻挡层,广义而言,具有电子输送层的功能,其包含具有输送电子的功能、同时输送空穴的能力显著小的空穴阻挡材料,通过一面输送电子一面阻挡空穴,可提高电子与空穴的再结合概率。

[0145] 优选为在空穴阻挡层中使用本发明的通式(1)所表示的碳硼烷化合物,在将所述碳硼烷化合物用于其他任意有机层的情形时,也可使用公知的空穴阻挡层材料。又,作为空穴阻挡层材料,可视需要而使用下文所述的电子输送层的材料。

[0146] -电子阻挡层-

[0147] 所谓电子阻挡层,包含具有输送空穴的功能、同时输送电子的能力显著小的材料,通过一面输送空穴一面阻挡电子,可提高电子与空穴再结合的概率。

[0148] 作为电子阻挡层的材料,可视需要而使用下文所述的空穴输送层的材料。电子阻挡层的膜厚优选为3nm~100nm,更优选为5nm~30nm。

[0149] -激子阻挡层-

[0150] 所谓激子阻挡层是用以阻挡通过在发光层内空穴与电子再结合而产生的激子向电荷输送层扩散的层,通过插入本层,可将激子有效地封入发光层内,而可提高元件的发光效率。激子阻挡层可邻接于发光层而插入至阳极侧、阴极侧中的任一侧,还可同时插入至两侧。

[0151] 作为激子阻挡层的材料,可使用通式(1)所表示的碳硼烷化合物,作为其他材料,例如,可列举1,3-二咔唑基苯(mCP)、或双(2-甲基-8-羟基喹啉(quinolinoIato))-4-苯基苯酚铝(III)(BAIq)。

[0152] -空穴输送层-

[0153] 所谓空穴输送层,包含具有输送空穴的功能的空穴输送材料,空穴输送层可设置单层或多层。

[0154] 作为空穴输送材料,是具有空穴的注入或输送、电子的障壁性中的任一者的材料,可为有机物、无机物中的任一者。作为可使用的公知的空穴输送材料,优选为使用通式(1)所表示的碳硼烷化合物,还可自现有公知的化合物中选择任意者而使用。作为可使用的公知的空穴输送材料,例如可列举三唑衍生物、噁二唑衍生物、咪唑衍生物、聚芳基烷烃衍生物、吡唑啉衍生物及吡唑啉酮衍生物、苯二胺衍生物、芳基胺衍生物、氨基取代查耳酮衍生物、噁唑衍生物、苯乙烯基蒽衍生物、茚酮衍生物、脞衍生物、二苯乙烯衍生物、硅氮烷衍生物、苯胺系共聚物、或导电性高分子低聚物、尤其是噻吩低聚物等,优选为使用卟啉化合物、芳香族三级胺化合物及苯乙烯基胺化合物,更优选为使用芳香族三级胺化合物。

[0155] -电子输送层-

[0156] 所谓电子输送层,包含具有输送电子的功能的材料,电子输送层可设置单层或多层。

[0157] 作为电子输送材料(还存在兼作空穴阻挡材料的情形),只要具有将自阴极注入的电子传送至发光层的功能即可。电子输送层优选为使用本发明的通式(1)所表示的碳硼烷化合物,还可自现有公知的化合物中选择任意者而使用,例如可列举:硝基取代茚衍生物、二苯基醌衍生物、二氧化噻喃衍生物、碳二亚胺、亚苄基甲烷衍生物、蒽醌二甲烷及蒽酮衍生物、噻二唑衍生物等。进而,在所述噻二唑衍生物中,将噻二唑环的氧原子取代为硫原子而成的噻二唑衍生物、具有已知为拉电子基的喹啉环的喹啉衍生物还可用作电子输送材料。进而,还可使用将这些材料导入至高分子链、或将这些材料作为高分子的主链的高分子材料。

[0158] [实施例]

[0159] 以下,通过实施例对本发明加以更详细的说明,但本发明当然不限于这些实施例,只要不超出其主旨,则能以各种方式而实施。

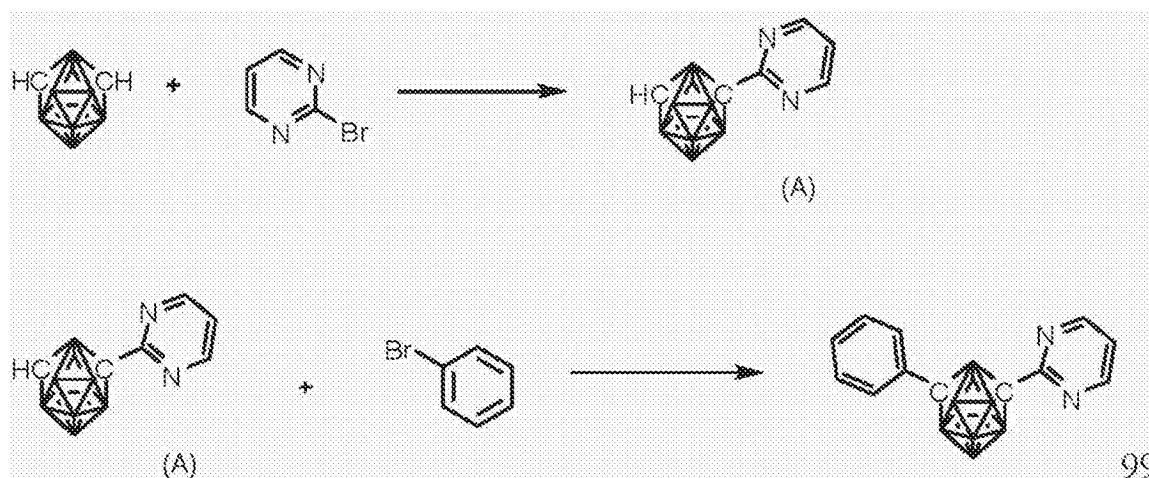
[0160] 通过以下所示的路径来合成成为有机电场发光元件用材料的碳硼烷化合物。再者,化合物编号与对所述化学式标注的编号相对应。

[0161] 实施例1

[0162] 依照以下的反应式来合成化合物99。

[0163] [化20]

[0164]



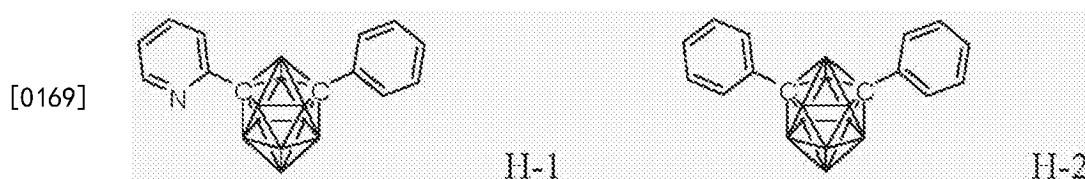
[0165] 在氮气环境下添加间碳硼烷35.0g (0.243mol)、1,2-二甲氧基乙烷(1,2-dimethoxy ethane,DME) 200mL,将所得的DME溶液冷却至0℃为止。滴加2.69M的正丁基锂己烷溶液96.8mL,在冰浴冷却下搅拌30分钟。添加吡啶70mL,在室温下搅拌10分钟后,添加氯化铜(I) 75.6g (0.763mol),在65℃下搅拌30分钟。其后,添加2-溴嘧啶44.5g (0.280mol),在95℃下搅拌一夜。将反应溶液冷却至室温后,滤取所析出的结晶,将溶剂减压蒸馏去除。利用硅胶管柱色谱法对所得的残渣进行纯化,获得中间体A 23.3g (0.104mmol,产率为43.0%)。

[0166] 在氮气环境下添加中间体A 5.49g (0.0245mol)、1,2-二甲氧基乙烷(DME) 138mL,将所得的DME溶液冷却至0℃为止。滴加2.69M的正丁基锂己烷溶液9.89mL,在冰浴冷却下搅拌30分钟。添加吡啶6.7mL,在室温下搅拌10分钟后,添加氯化铜(I) 7.56g (76.0mmol),在65

℃下搅拌30分钟。其后,添加溴苯4.11g (0.0262mol),在95℃下搅拌两天。将反应溶液冷却至室温后,滤取所析出的结晶,将溶剂减压蒸馏去除。利用硅胶管柱色谱法对所得的残渣进行纯化,获得化合物991.47g (4.90mmol,产率为20%)。大气压化学电离-飞行时间质谱 (Atmospheric Pressure Chemical Ionization Time-of-flight Mass Spectrometry, APCI-TOFMS)、 m/z 301 $[M+H]^+$

[0167] 根据所述合成例以及说明书中记载的合成方法,合成化合物6、化合物9、化合物39、化合物53、化合物73、化合物96、以及用以进行比较的化合物H-1及化合物H-2。使用这些化合物99、化合物6、化合物9、化合物39、化合物53、化合物73、化合物96、化合物H-1或化合物H-2来制作有机EL元件。

[0168] [化21]



[0170] 实施例2

[0171] 在形成有包含膜厚70nm的氧化铟锡 (ITO) 的阳极的玻璃基板上,通过真空蒸镀法以 2.0×10^{-5} Pa的真空度来层叠各薄膜。首先,在ITO上以30nm的厚度形成铜酞菁 (CuPC) 作为空穴注入层。继而,以15nm的厚度形成二苯基萘基二胺 (NPD) 作为空穴输送层。继而,在空穴输送层上,自不同的蒸镀源来共蒸镀作为发光层的主体材料的化合物99与作为掺杂物的Ir (ppy)₃,以30nm的厚度形成发光层。Ir (ppy)₃的浓度为10wt%。继而,以25nm的厚度形成Alq₃作为电子输送层。进而,在电子输送层上以1nm的厚度形成氟化锂 (LiF) 作为电子注入层。最后,在电子注入层上以70nm的厚度形成铝 (Al) 作为电极,制作有机EL元件。

[0172] 对所得的有机EL元件连接外部电源并施加直流电压,结果确认到具有如表1所示的发光特性。在表1中,显示在20mA/cm²下驱动时的亮度、电压及发光效率的值 (初始特性)。得知元件发光光谱的最大波长为530nm,获得了来自Ir (ppy)₃的发光。

[0173] 实施例3~实施例14

[0174] 除了使用化合物6、化合物9、化合物39、化合物53、化合物73、化合物77、化合物78、化合物79、化合物85、化合物96、化合物105或化合物114代替化合物99作为实施例2中的发光层的主体材料以外,与实施例2同样地制作有机EL元件。

[0175] 比较例1~比较例3

[0176] 除了使用CBP、H-1或H-2作为实施例2中的发光层的主体材料以外,与实施例2同样地制作有机EL元件。

[0177] 与实施例2同样地对实施例3~实施例14以及比较例1~比较例3中所得的有机EL元件进行评价,结果确认到具有如表1所示的发光特性。再者可确定,实施例3~实施例14以及比较例1~比较例3中所得的有机EL元件的发光光谱的最大波长为530nm,获得来自Ir (ppy)₃的发光。

[0178] [表1]

[0179]

	主体材料 化合物	亮度 (cd/m ²)	电压 (V)	视感发光效率 (lm/W)
实施例 2	99	1200	7.0	2.8
实施例 3	6	1200	7.9	2.3
实施例 4	9	1200	6.5	2.8
实施例 5	39	1200	7.7	2.4
实施例 6	53	1200	6.5	2.8
实施例 7	73	1200	6.0	3.0
实施例 8	96	1200	6.5	2.8
实施例 9	77	1100	6.5	2.6
实施例 10	78	1100	6.4	2.7
实施例 11	79	1200	6.4	2.8
实施例 12	85	1200	6.4	2.8
实施例 13	105	1100	6.2	2.7
实施例 14	114	1100	6.2	2.7
比较例 1	CBP	1100	8.7	2.0
比较例 2	H-1	1100	8.8	2.0
比较例 3	H-2	1100	10.0	1.8

[0180] 根据表1,在将本发明的碳硼烷化合物用于发光层的情形(实施例1~实施例14)时,与此以外的情形(比较例1~比较例3)相比而显示出良好的发光效率。

[0181] 实施例15

[0182] 在形成有包含膜厚70nm的氧化铟锡(ITO)的阳极的玻璃基板上,通过真空蒸镀法以 2.0×10^{-5} Pa的真空气度层叠各薄膜。首先,在ITO上以30nm的厚度形成铜酞菁(CuPC)作为空穴注入层。进而,以15nm的厚度形成二苯基萘基二胺(NPD)作为空穴输送层。继而,在空穴输送层上自不同的蒸镀源来共蒸镀作为发光层的主体材料的CBP与作为掺杂物的Ir(ppy)₃,以30nm的厚度形成发光层。Ir(ppy)₃的浓度为10%。继而,在发光层上以5nm的厚度形成化合物99作为空穴阻挡层。继而,以20nm的厚度形成Alq₃作为电子输送层。进而,在电子输送层上以1.0nm的厚度形成氟化锂(LiF)作为电子注入层。最后,在电子注入层上以70nm的厚度形成铝(Al)作为电极。所得的有机EL元件具有如下层构成:在图1所示的有机EL元件中,在阴极与电子输送层之间追加电子注入层,及在发光层与电子输送层之间追加空穴阻挡层。

[0183] 对所得的有机EL元件连接外部电源并施加直流电压,结果确认到具有如表2所示的发光特性。在表2中,亮度、电压及发光效率表示在20mA/cm²下驱动时的值(初始特性)。得知元件发光光谱的最大波长为530nm,获得了来自Ir(ppy)₃的发光。

[0184] 实施例16~实施例27

[0185] 除了使用化合物6、化合物9、化合物39、化合物53、化合物73、化合物77、化合物78、

化合物79、化合物85、化合物96、化合物105或化合物114代替化合物99作为实施例15中的空穴阻挡层的材料以外,与实施例15同样地制作有机EL元件。

[0186] 比较例4

[0187] 除了将实施例15中的作为电子输送层的Alq₃的膜厚设定为25nm,且不设置空穴阻挡层以外,与实施例15同样地制作有机EL元件。

[0188] 比较例5~比较例6

[0189] 除了使用化合物H-1、化合物H-2作为实施例15中的空穴阻挡材料以外,与实施例15同样地制作有机EL元件。

[0190] 与实施例15同样地对实施例16~实施例27以及比较例4~比较例6中所得的有机EL元件进行评价,结果确认到具有如表2所示的发光特性。可确定,实施例16~实施例27以及比较例4~比较例6中所得的有机EL元件的发光光谱的最大波长为530nm,获得来自Ir(ppy)₃的发光。再者,实施例16~实施例27以及比较例4~比较例6中使用的发光层的主体材料均为CBP。

[0191] [表2]

[0192]

	空穴阻挡材料 化合物	亮度 (cd/m ²)	电压 (V)	视感发光效率(lm/W)
实施例 15	99	1400	7.5	3.0
实施例 16	6	1200	8.5	2.1
实施例 17	9	1400	7.0	3.2
实施例 18	39	1200	8.2	2.3
实施例 19	53	1300	7.0	2.8
实施例 20	73	1400	6.5	3.5
实施例 21	96	1400	6.9	3.2
实施例 22	77	1300	6.9	2.8
实施例 23	78	1400	6.9	3.3
实施例 24	79	1400	6.9	3.3
实施例 25	85	1400	6.9	3.2
实施例 26	105	1300	6.7	3.0
实施例 27	114	1300	6.6	3.1
比较例 4	-	1100	8.7	2.0
比较例 5	H-1	1100	9.7	1.8
比较例 6	H-2	1100	10.9	1.6

[0193] 根据表2,虽与未使用空穴阻挡材料的比较例4相比,可在所有的系统中确认到初始特性的改善,但其中在将本发明的碳硼烷化合物用于空穴阻挡层的情形时显示出良好的特性。

[0194] [产业上的可利用性]

[0195] 本发明的有机电场发光元件用材料在显示出良好的非晶特性与高的热稳定性的同时,在激发状态下极其稳定,故使用其的有机EL元件的驱动寿命长而具有实用水平的耐久性。

[0196] [符号的说明]

[0197] 1:基板

[0198] 2:阳极

[0199] 3:空穴注入层

[0200] 4:空穴输送层

[0201] 5:发光层

[0202] 6:电子输送层

[0203] 7:阴极

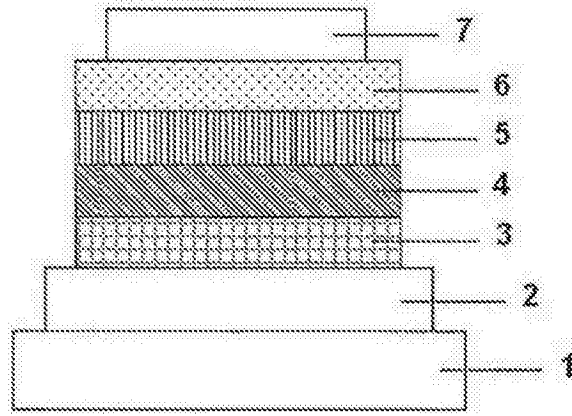


图1

专利名称(译)	有机电场发光元件用材料及使用其的有机电场发光元件		
公开(公告)号	CN107408638A	公开(公告)日	2017-11-28
申请号	CN201680017249.0	申请日	2016-03-08
[标]申请(专利权)人(译)	新日铁化学株式会社		
申请(专利权)人(译)	新日铁住金化学株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	新日铁住金化学株式会社		
[标]发明人	上田季子 小川淳也 甲斐孝弘 多田匡志		
发明人	上田季子 小川淳也 甲斐孝弘 多田匡志		
IPC分类号	H01L51/50 C07F5/02 C09K11/06		
CPC分类号	C09K11/025 C07F5/02 C09K11/06 H01L51/50 C09K2211/1007 C09K2211/1029 C09K2211/185 H01L51/005 H01L51/0067 H01L51/5016 H01L51/5072 H01L51/5096 H01L51/5206 H01L51/5221		
优先权	2015070105 2015-03-30 JP		
其他公开文献	CN107408638B		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种改善元件的发光效率、充分确保驱动稳定性、且具有简略的构成的有机电场发光元件(有机EL元件)及其所使用的有机EL元件用材料。一种包含通式(1)所表示的碳硼烷化合物的有机EL元件用材料，所述碳硼烷化合物具有包含至少两个氮的六元环基键结于碳硼烷环的结构。所述有机EL元件用材料适合作为包含磷光发光性掺杂物与主体材料的发光层的主体材料、或作为空穴阻挡层的材料。式中，环A为式(1a)或式(1b)所表示的二价碳硼烷基，X的两个以上为N。

